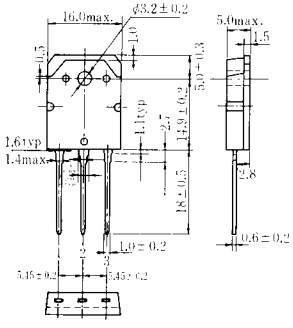
2SD1496

コン NPN 三重拡散形
高圧電力スイッチング用
水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
3. エミッタ：Emitter

(Dimensions in mm)

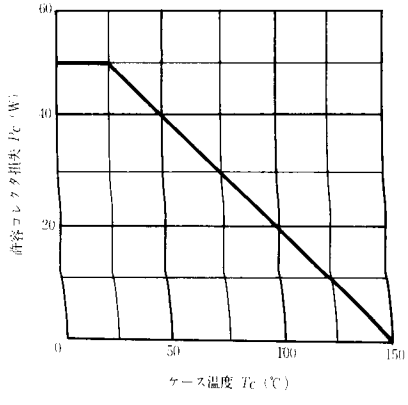
(TO-3P)

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SD1496	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	600	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	5	A
サージコレクタ電流	$I_{C(surge)}$	16	A
許容コレクタ損失	P_C*	50	W
許容コレクタ損失	P_C**	20	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	℃

*T_C=25℃における許容値。
**シリコンオイルを塗布した付属のマイカ板を介して放熱板(200mm×300mm×1.5mmアルミ板)に取付けた時の許容値。
*Value at T_C=25℃
**Value when attach on the haet sink plate (200mm×300mm×1.5mm Al)

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=10mA, R_{BE}=∞	500	–	–	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=10mA, I_C=0	6	–	–	V
コレクタ遮断電流	I_{CBX}	V_{CB}=1500V, V_{EB}=1.5V	–	–	1	mA
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=4.5A, I_B=1.2A	–	–	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=4.5A, I_B=1.2A	–	–	1.5	V
下降時間	t_f	I_C=3A, I_{B1}≒0.7A, I_{B2}≒−2.7A, L_B=0	–	–	2.3	μs